

東芝 CMOS集積回路 シリコン モノリシック

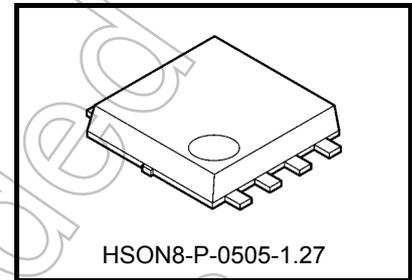
TCV7101F

降圧型DC-DCコンバータIC

TCV7101Fは降圧型DC-DCコンバータ用1チップICです。
高速・低オン抵抗のパワーMOSFETを内蔵しており、外付けローサイドMOSFETによる同期整流方式、または外付けダイオード整流方式に対応し、高い効率を実現することが可能です。

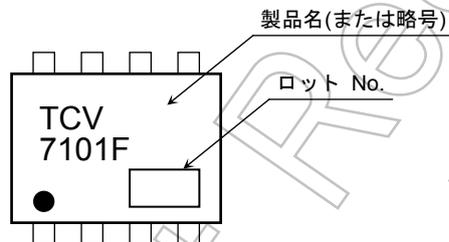
特長

- 少ない外付け部品で大電流ドライブが可能です。 $I_{OUT} = 3.8\text{ A}$ (最大)
- 高効率： $\eta = 95\%$ (標準)(@ $V_{IN} = 5\text{ V}$, $V_{OUT} = 3.3\text{ V}$, $I_{OUT} = 1.5\text{ A}$)
(ローサイドMOSFET TPC6008-H使用時)
- 動作電源電圧： $V_{IN} = 2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$
- 低オン抵抗： $R_{DS(ON)} = 0.08\ \Omega$ (標準)
(@ハイサイド, $V_{IN} = 5\text{ V}$, $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$)
- 発振周波数： $f_{OSC} = 600\text{ kHz}$ (標準)
- 基準電圧： $V_{FB} = 0.8\text{ V} \pm 1\%$ (@ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$)
- 同期整流用Nch MOSFETドライブ内蔵
- 内部位相補償方式を採用しているため、少ない外付け部品で高効率の電源を実現できます。
- 出力平滑用コンデンサに小型のセラミックコンデンサが使用可能です。
- 低熱抵抗の小型面実装パッケージ(SOP Advance)を採用しています。
- 外付けコンデンサにより時間調整可能なソフトスタート機能内蔵



質量：0.068 g (標準)

現品表示



正面から見てマーク左下のドット (●) が1番端子を示しています。

*: ロット No.

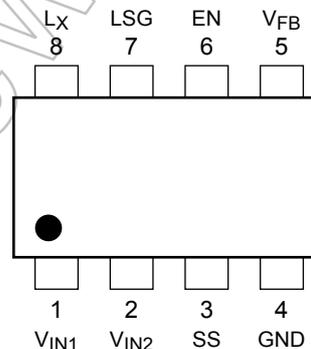
3桁算用数字で構成し、西暦年号の末尾1桁、および残りの2桁は製造週とする。



製造週コード (その年の第一週を01とし、以降52または53まで)

製造年コード (西暦の末尾1桁)

端子配置図



この製品はMOS構造ですので取り扱いの際には静電気にご注意ください。

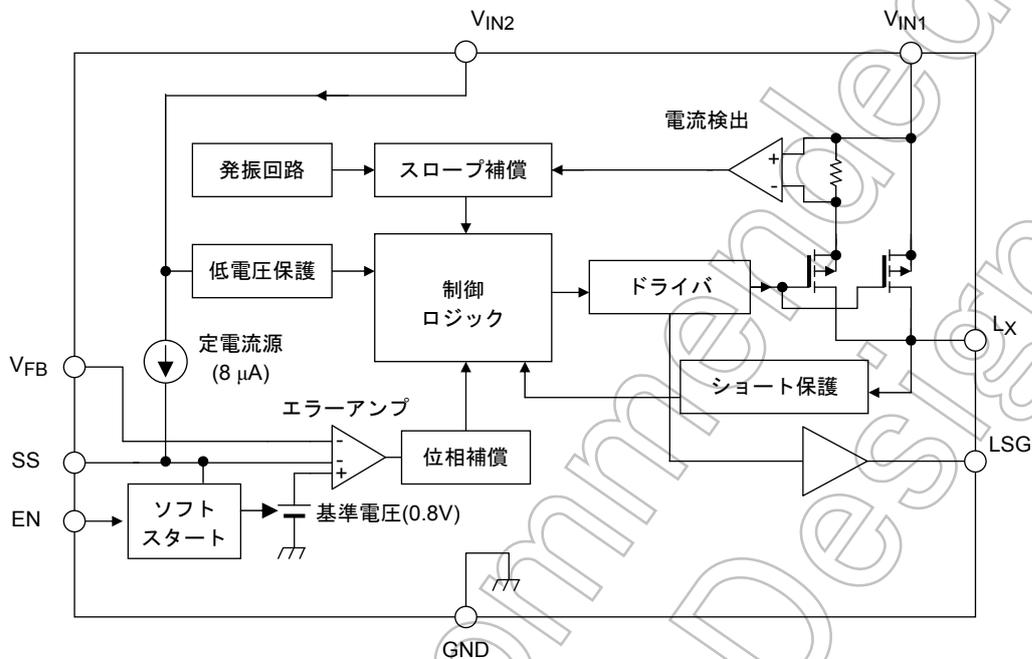
本製品に内蔵される保護機能は、短時間の過電流、過熱など、一時的且つわずかな程度に過剰な負荷から本製品を保護するための機能であり、いかなる場合でも本製品を保護するというものではありません。本製品をお客様のシステムに使用する場合は、本製品への上記負荷を回避し且つ上記負荷が発生次第直ちに上記負荷を解除するようお客様のシステムを設計してください。

製品量産開始時期
2008-05

オーダー方法

製品名	包装形態と発注単位
TCV7101F (TE12L, Q)	エンボステープング: (3000 個/リール)

ブロック図



端子説明

端子番号	端子記号	端子の説明
1	V _{IN1}	出力部入力端子 V _{EN} =“L”となるとスタンバイ状態となり、消費電流は 10 μA 以下となります。
2	V _{IN2}	制御部入力端子 V _{EN} =“L”となるとスタンバイ状態となり、消費電流は 10 μA 以下となります。
3	SS	ソフトスタート端子 この端子をオープンとした場合には 1ms(標準)のソフトスタート時間となります。また外付けのコンデンサによってソフトスタート時間を可変できます。8 μA(標準)で外付けコンデンサの充電電流を供給し、0~0.8V の電圧範囲でエラーアンプ基準電圧を入力します。EN=L の時及び低電圧、過熱検出時には外付けコンデンサを放電します。
4	GND	接地端子
5	V _{FB}	フィードバック端子 0.8V(標準)の基準電圧に接続された、エラーアンプを内蔵しています。
6	EN	イネーブル端子 1.5V 以上(@V _{IN} =5V)の電圧が印加されると内部回路が起動し、スイッチング動作が開始されます。0.5V(@V _{IN} =5V)以下の電圧で、内部回路の動作を停止しスタンバイモードになります。 この端子は約 500kΩ のプルダウン抵抗を内蔵しています。
7	LSG	ローサイドスイッチゲートドライブ端子
8	L _x	スイッチング端子 ハイサイドの Pch MOS FET が接続されています。

絶対最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
出力部入力端子電圧	V _{IN1}	-0.3~6	V
制御部入力端子電圧	V _{IN2}	-0.3~6	V
ソフトスタート端子電圧	V _{SS}	-0.3~6	V
フィードバック端子電圧	V _{FB}	-0.3~6	V
イネーブル端子電圧	V _{EN}	-0.3~6	V
イネーブル・入力端子間電圧	V _{EN-VIN2}	V _{EN-VIN2} <0.3	V
L S G 端子電圧	V _{LSG}	-0.3~6	V
スイッチング端子電圧(注1)	V _{LX}	-0.3~6	V
スイッチング端子電流	I _{LX}	-4.6	A
許容損失(注2)	P _D	2.2	W
動作接合部温度	T _{jopr}	-40~125	°C
接合部温度(注3)	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~150	°C

注: 本製品の使用条件(使用温度/電流/電圧等)が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷(高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等)で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック(取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法)および個別信頼性情報(信頼性試験レポート、推定故障率等)をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

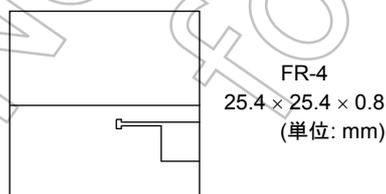
注1: スwitching端子電圧(V_{LX})は本製品のswitchingによって発生するピーク電圧を含まない値です。switching素子のデッドタイム時に発生する負電圧は、switching端子電流(I_{LX})の範囲で許容されます。

熱抵抗特性

項目	記号	最大	単位
接合部・外気間熱抵抗	R _{th(j-a)}	44.6(注2)	°C/W
接合部・ケース間熱抵抗(T _c =25°C)	R _{th(j-c)}	4.17	°C/W

注2

ガラスエポキシ基板



単発パルス測定: パルス幅 t=10(s)

注3 最大接合部温度では過熱保護回路が作動することがあります。最大動作接合部温度を超えることのない放熱条件でご使用ください。

電气的特性 (T_j = 25°C、条件がないものについては、V_{IN1} = V_{IN2} = 2.7 V ~ 5.5 V)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
動作入力電圧	V _{IN(OPR)}	—	2.7	—	5.5	V
消費電流	I _{IN}	V _{IN1} = V _{IN2} = V _{EN} = V _{FB} = 5 V	—	450	600	μA
出力可能電圧範囲	V _{OUT(OPR)}	V _{EN} = V _{IN1} = V _{IN2}	0.8	—	—	V
スタンバイ電流	I _{IN(STBY)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V, V _{EN} = 0 V V _{FB} = 0.8 V	—	—	10	μA
	I _{IN(STBY)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3 V, V _{EN} = 0 V V _{FB} = 0.8 V	—	—	10	
ハイサイドスイッチリーク電流	I _{LEAK(H)}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V, V _{EN} = 0 V V _{FB} = 0.8 V, V _{LX} = 0 V	—	—	10	μA
イネーブル端子しきい値電圧	V _{IH(EN)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V	1.5	—	—	V
	V _{IH(EN)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3 V	1.5	—	—	
	V _{IL(EN)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V	—	—	0.5	
	V _{IL(EN)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3 V	—	—	0.5	
イネーブル端子電流	I _{IH(EN)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V, V _{EN} = 5 V	6	—	13	μA
	I _{IH(EN)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3 V, V _{EN} = 3.3 V	4	—	9	
フィードバック端子電圧	V _{FB1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V, V _{EN} = 5 V T _j = 0 ~ 85°C	0.792	0.8	0.808	V
	V _{FB2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3 V, V _{EN} = 3.3 V T _j = 0 ~ 85°C	0.792	0.8	0.808	
フィードバック端子電流	I _{FB}	V _{IN1} = V _{IN2} = 2.7 V ~ 5.5 V V _{FB} = V _{IN2}	-1	—	1	μA
ハイサイドスイッチオン抵抗	R _{DS(ON)(H)1}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V, V _{EN} = 5 V I _{LX} = -1.5 A	—	0.08	—	Ω
	R _{DS(ON)(H)2}	V _{IN1} = V _{IN2} = 3.3 V, V _{EN} = 3.3 V I _{LX} = -1.5 A	—	0.1	—	
LSG端子ハイサイドオン抵抗	R _{LSG(ON)(H)}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V	—	0.8	—	Ω
LSG端子ローサイドオン抵抗	R _{LSG(ON)(L)}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V	—	0.4	—	
発振周波数	f _{OSC}	V _{IN1} = V _{IN2} = V _{EN} = 5 V	480	600	720	kHz
内部ソフトスタート時間	t _{SS}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V, I _{OUT} = 0 A V _{OUT} が 90% となるまでの時間	0.5	1	1.5	ms
外部ソフトスタート充電電流	I _{SS}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V, V _{EN} = 5 V	-5	-8	-11	μA
ハイサイドスイッチオンデューティ	D _{max}	V _{IN1} = V _{IN2} = 2.7 V ~ 5.5 V	—	—	100	%
過熱保護	検出温度	T _{SD}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V	—	150	°C
	ヒステリシス	ΔT _{SD}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V	—	15	
低電圧保護	検出電圧	V _{UV}	V _{EN} = V _{IN1} = V _{IN2}	2.35	2.45	V
	解除電圧	V _{UVR}	V _{EN} = V _{IN1} = V _{IN2}	2.45	2.55	
	ヒステリシス	ΔV _{UV}	V _{EN} = V _{IN1} = V _{IN2}	—	0.1	
スイッチング端子ピーク電流制限	I _{LIM}	V _{IN1} = V _{IN2} = 5 V, V _{OUT} = 2 V	4.4	6.2	—	A

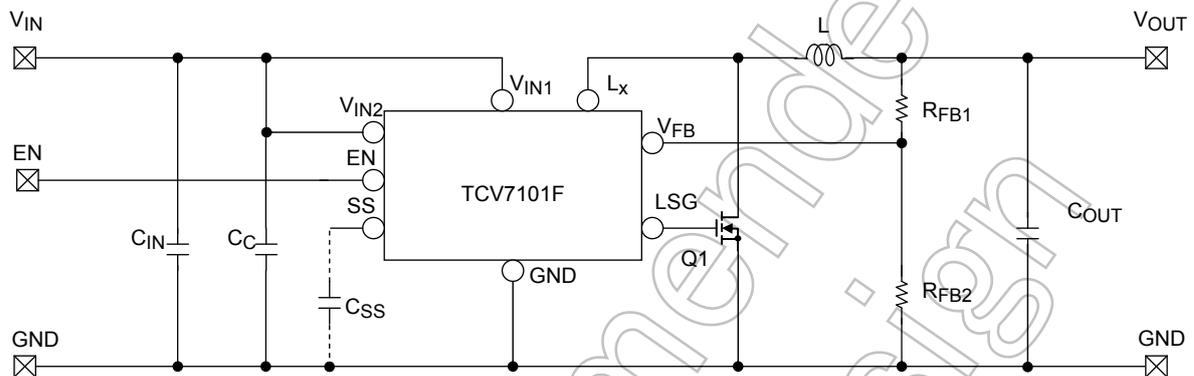
電氣的特性共通事項

各項目測定条件内の $T_j = 25^\circ\text{C}$ とは、パルス試験を実施しチップの接合部温度上昇による特性値のドリフトを無視できる状態での規定です。

応用回路例

C_{OUT} に低 ESR の電解コンデンサまたはセラミックコンデンサを使用した標準的な応用例

外付けローサイド MOSFET 使用時



外付けショットキーバリアダイオード使用時

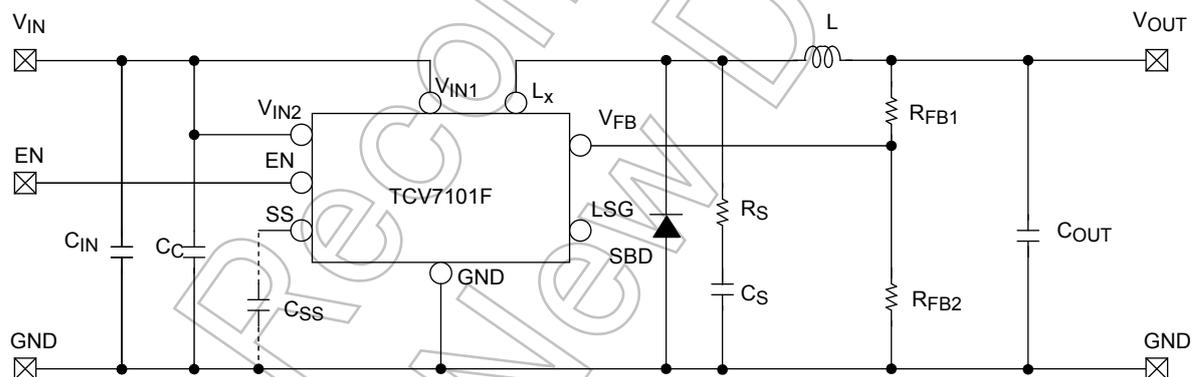


図 1 標準的な TCV7101F 応用回路例

部品定数 (参考値@ $V_{IN} = 5\text{V}$, $V_{OUT} = 3.3\text{V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

- Q1 : ローサイド FET (Nch MOSFET: 株式会社東芝 TPC6008-H または TPC6012(T5LS,F))
- SBD : ローサイドショットキーバリアダイオード(ショットキーバリアダイオード: 株式会社東芝 CMS05)
- C_{IN} : 入力平滑用コンデンサ 10 μF (セラミックコンデンサ: 株式会社村田製作所 GRM21BB30J106K)
- C_{OUT} : 出力平滑用コンデンサ 47 μF (セラミックコンデンサ: 株式会社村田製作所 GRM31CB30J476M)
- C_C : デカップリングコンデンサ 1 μF (セラミックコンデンサ: 株式会社村田製作所 GRM155B30J105K)
- R_{FB1} : 出力電圧設定用抵抗 7.5 k Ω
- R_{FB2} : 出力電圧設定用抵抗 2.4 k Ω
- R_S : スナバ回路用抵抗 10 Ω
- C_S : スナバ回路用コンデンサ 220 pF (セラミックコンデンサ: 株式会社村田製作所 GRM1552C1H221J)
- L : インダクタ 2.2 μH (TDK-EPC 株式会社 RLF7030T-2R2M5R4)

C_{SS} はソフトスタート時間を可変するためのコンデンサです。

部品定数設定例 (参考値)

出力電圧設定 V _{OUT}	インダクタンス L	入力平滑 コンデンサ容量 C _{IN}	出力平滑 コンデンサ容量 C _{OUT}	フィードバック抵抗 R _{FB1}	フィードバック抵抗 R _{FB2}
1.2 V	2.2 μH	10 μF	100 μF	7.5 kΩ	15 kΩ
1.51 V	2.2 μH	10 μF	100 μF	16 kΩ	18 kΩ
1.8 V	2.2 μH	10 μF	100 μF	15 kΩ	12 kΩ
2.5 V	2.2 μH	10 μF	47 μF	5.1 kΩ	2.4 kΩ
3.3 V	2.2 μH	10 μF	47 μF	7.5 kΩ	2.4 kΩ

部品定数は、入出力条件および基板レイアウト等により設定が必要です。

応用方法

インダクタの選定

インダクタンスは、(1) 式より求められます。

$$L = \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{f_{osc} \cdot \Delta I_L} \cdot \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \dots\dots(1)$$

V_{IN} : 入力電圧 (V) f_{osc}: 発振周波数 (Hz) = 600kHz (標準)
 V_{OUT}: 出力電圧 (V) ΔI_L: インダクタのリプル電流 (A)

*: 通常、ΔI_Lは最大出力電流の30%程度に設定します。本製品では、出力電流 I_{OUT} = 3.8 A (最大) であるため、ΔI_Lは1.14 A程度になります。インダクタの定格電流はピーク電流となる4.4A以上の製品を選定してください。インダクタの定格電流を越えた場合、インダクタが磁気飽和してDC-DCコンバータとしての動作が不安定になる恐れがあります。

V_{IN} = 5 V, V_{OUT} = 3.3 V の条件では、次のようにインダクタンスを算出できます。インダクタンスは入力電圧範囲を考慮して最適な定数を設定してください。

$$L = \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{f_{osc} \cdot \Delta I_L} \cdot \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}$$

$$= \frac{5\text{ V} - 3.3\text{ V}}{600\text{ kHz} \cdot 1.14\text{ A}} \cdot \frac{3.3\text{ V}}{5\text{ V}}$$

$$= 1.64\ \mu\text{H} \dots\dots(2)$$

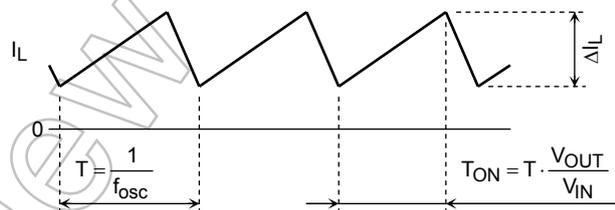


図2 インダクタ電流波形

出力電圧の設定

本製品は、フィードバック端子(V_{FB})に接続されたエラーアンプの基準電圧0.8 V (標準) を基に、R_{FB1} と R_{FB2} の分割抵抗によって出力電圧を設定します。出力電圧は (3) 式から求められます。なお、R_{FB1} の値が極端に大きい場合には、フィードバック端子の寄生容量により遅れ時間が発生しますので、R_{FB1} は 30 kΩ 程度を最大としてください。出力電圧精度を確保するため±1%以下の高精度抵抗の使用を推奨します。

$$V_{OUT} = V_{FB} \cdot \left(1 + \frac{R_{FB1}}{R_{FB2}} \right)$$

$$= 0.8\text{ V} \cdot \left(1 + \frac{R_{FB1}}{R_{FB2}} \right) \dots\dots(3)$$

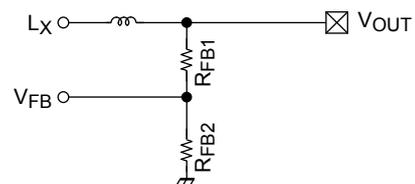


図3 出力電圧設定抵抗

出力平滑用コンデンサの選定

出力平滑用コンデンサは、低 ESR の電解コンデンサまたはセラミックコンデンサを使用してください。コンデンサの特性は温度により影響を受けますので、温度特性が良好な製品を選定してください。また、容量値は出力電圧 2 V 以上の設定では 47 μF 以上、2 V 未満の設定では、100 μF 以上を目安とし、セット規格のリプル電圧と、負荷応答特性を満足するような最適な容量値の選定をお願いします。出力電圧設定値が低い程、位相余裕度が少なくなる傾向があります。位相余裕度が不足する場合や、負荷応答特性を満足できない場合は、出力平滑用コンデンサの容量値を大きくしてください。なお、セラミックコンデンサは ESR（等価直列抵抗）が非常に小さいため、出力電圧リプルを低減できますが、位相余裕度が少なくなりますので、十分な評価を実施してください。

本製品はフィードバック端子に位相補償回路を追加することにより、出力平滑用コンデンサを前記より小さい値で使用する事が可能です。出力平滑用コンデンサに 30 μF(10 μF ×3)のセラミックコンデンサを使用した場合、以下のように位相補償回路を設定します。

$$C_{P1}(\mu F) = 2 / R_{FB1}(\Omega) \dots (4)$$

$$C_{P2}(\mu F) = C_{P1}(\mu F) \times 10 \dots (5)$$

$$R_{FB2} // R_P = R_{FB1} / 2 \dots (6)$$

- * C_{P1} と R_{FB1} による高域上昇のカットオフ周波数を 60kHz ($f_{OSC}/10$) 程度に設定します…(4)
- * C_{P2} で上記の周波数の 1/10 程度のゼロを作ります…(5)
- * R_{FB2} の値が R_{FB1} の 1/2 以下の値の時 R_P と C_{P2} は不要です…(6) ($V_{OUT}=1.8V$ 以上の設定は C_{P1} のみで可)

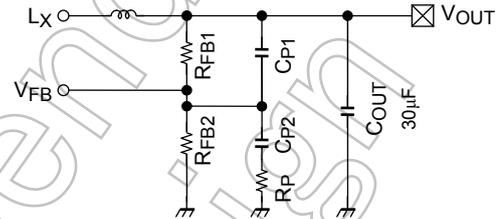


図 4 位相補償回路

位相補償回路定数設定例 (参考値)

部品定数は、入出力条件および基板レイアウト等により設定が必要です。

V _{OUT}	C _{OUT}	R _{FB1}	R _{FB2}	R _P	C _{P1}	C _{P2}
1.2 V	10 μFx3	7.5 kΩ	15 kΩ	4.7 kΩ	330 pF	3300 pF
1.51 V	10 μFx3	16 kΩ	18 kΩ	15 kΩ	150 pF	1500 pF
1.8 V	10 μFx3	15 kΩ	12 kΩ	-	220 pF	-
2.5 V	10 μFx3	5.1 kΩ	2.4 kΩ	-	470 pF	-
3.3 V	10 μFx3	7.5 kΩ	2.4 kΩ	-	330 pF	-

この回路では、 f_0 (開ループゲインが 0dB となる周波数) を高く設定することで、小さい出力平滑用コンデンサ容量で、良好な負荷応答特性を実現できます。出力平滑用コンデンサは ESR の小さく温度特性が良好な B 特性などのセラミックコンデンサを使用してください。外付けの位相補償回路により位相余裕度を確保することが可能となりますが、セット規格のリプル電圧と、負荷応答特性を満足できるよう十分な評価を実施してください。

整流素子の選定

本製品はローサイドスイッチまたはショットキーバリアダイオードを接続して使用してください。

ローサイドスイッチには NchMOSFET の TPC6008-H または TPC6012(T5LS,F)相当をご使用ください。(TPC6008-H は 4.5V 駆動製品のため、4.5V 以上の入力電圧でご使用ください)。その他の NchMOSFET を使用することも可能ですが、外付け MOSFET のスイッチング速度が遅いと、ローサイドスイッチとハイサイドスイッチが同時にオンする場合があります、貫通電流により不具合が発生することがあります。定格電流付近の動作で、Lx 端子の立ち上がり波形を観測し、ローサイドスイッチがオフした後、ハイサイドスイッチがオンになるまでの時間(デッドタイム)が 10ns 程度以上となっていることを確認してください。セットの使用条件でデッドタイムが確保できるよう十分な評価を実施してください。

ショットキーバリアダイオードには CMS05 相当をご使用ください。ショットキーバリアダイオードを使用するとき、Lx 端子波形に高いオーバーシュート電圧が発生する傾向があるため、ショットキーバリアダイオードと並列に $R_S = 10\Omega$ 、 $C_S = 220pF$ 程度の CR 直列素子を接続してください。ショットキーバリアダイオードは周囲温度の上昇や電流による自己発熱により、逆電流が増加し損失が増える傾向にありますので、ディレーティングを考慮し定格に余裕のあるものを選定してください。

ソフトスタート機能

本製品は出力電圧のソフトスタート機能を内蔵しています。
ソフトスタート端子をオープンにした場合、本製品に内蔵された内部ソフトスタート時間 $t_{SS} = 1 \text{ ms}$ (標準)によって出力電圧の供給を開始します。

また、ソフトスタート端子と GND 端子間に外付けコンデンサ C_{SS} を追加することによりソフトスタート時間の延長が可能です。外付けコンデンサによるソフトスタート時間は、(7)式により求められます。

$$t_{SS2} = 0.1 \cdot C_{SS} \dots\dots\dots(7)$$

t_{SS2} : 外付けコンデンサによるソフトスタート時間 (s)
 C_{SS} : ソフトスタートコンデンサ容量 (μF)

ソフトスタート動作は電源立ち上げによる低電圧保護解除時、もしくはイネーブル端子電圧が L→H となったときの出力電圧供給開始時に行います。

過電流保護機能

本製品は垂下型過電流保護機能を内蔵しています。Lx 端子電流のピーク値が、スイッチング端子ピーク電流制限 $I_{LIM}=6.2\text{A}$ (標準) を超えると、ハイサイドスイッチング素子の ON 時間を制限し出力電圧を低下させます。

低電圧保護機能

本製品は低電圧保護機能を内蔵しており、制御部入力電圧 V_{IN2} が低電圧保護解除電圧 $V_{UVR} = 2.55 \text{ V}$ (標準) を超えると、出力電圧 V_{OUT} の供給を開始します。低電圧保護機能は 0.1 V (標準) のヒステリシス特性を持っており、制御部入力電圧 V_{IN2} が低電圧保護検出電圧 $V_{UV} = 2.45 \text{ V}$ (標準) 以下になると出力電圧の供給を停止します。

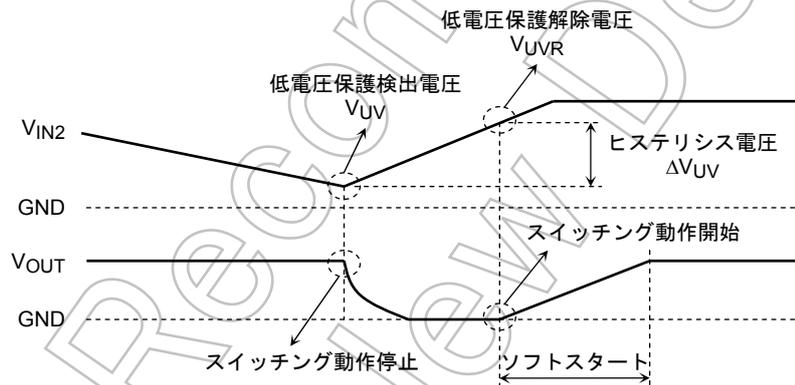


図5 低電圧保護動作

過熱保護機能

本製品は過熱保護機能を内蔵しています。接合部温度 T_j が過熱保護検出温度 $T_{SD} = 150^\circ\text{C}$ (標準) 以上となると過熱保護回路が作動して、出力電圧の供給を停止します。過熱保護回路は 15°C (標準) のヒステリシス特性を持ち、過熱保護が作動した後、接合部温度が 15°C 程度低下すると過熱保護が解除され、ソフトスタート動作を経て出力電圧の供給を再開します。

過熱保護機能はシステム異常時の安全性を高めるための機能であり、通常の動作状態で過熱保護が作動するような使用条件は避けてください。

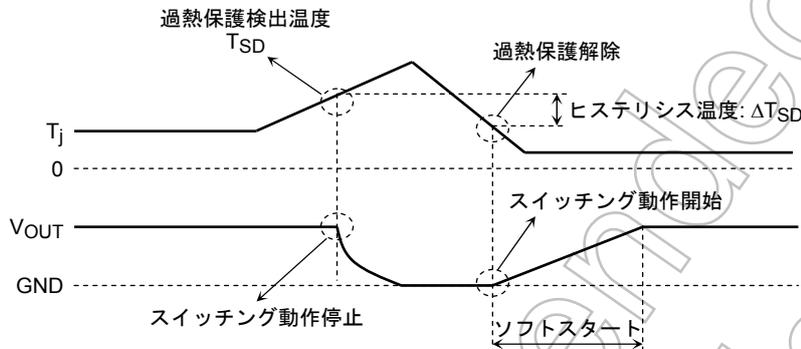
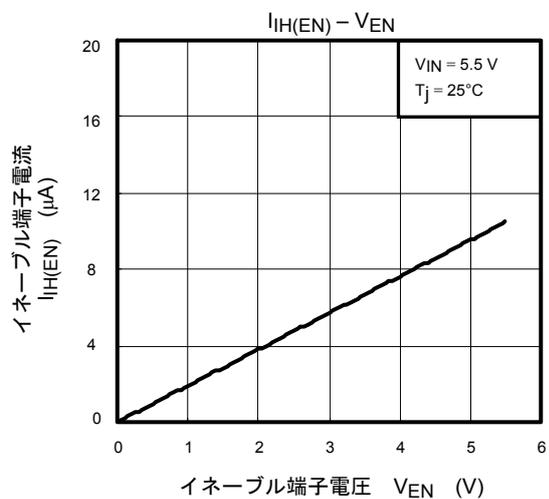
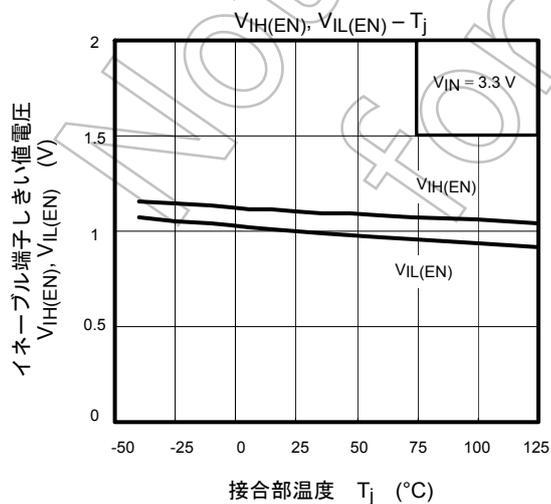
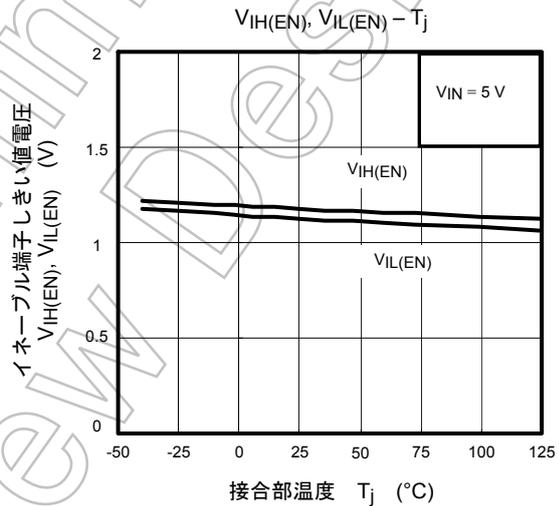
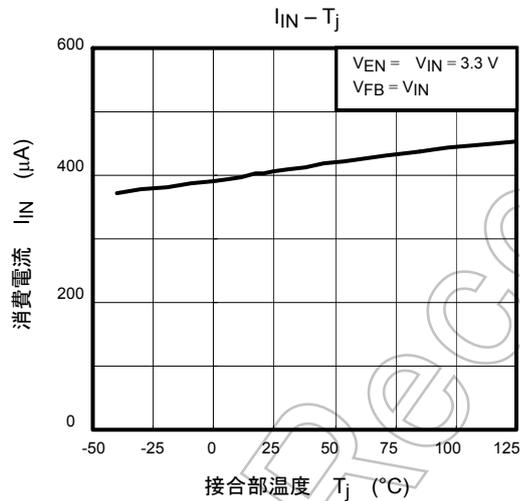
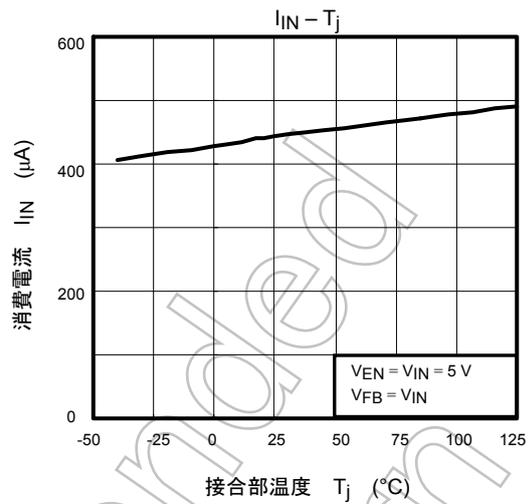
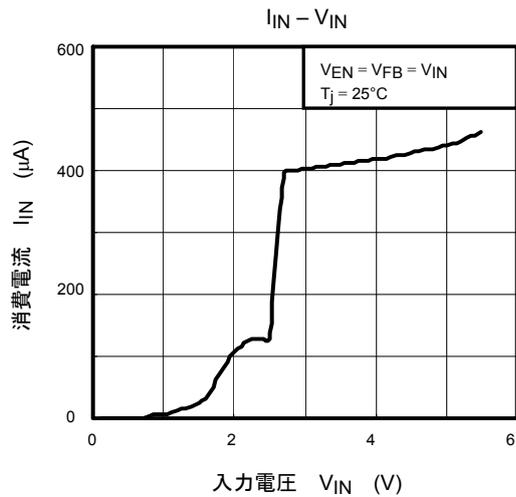


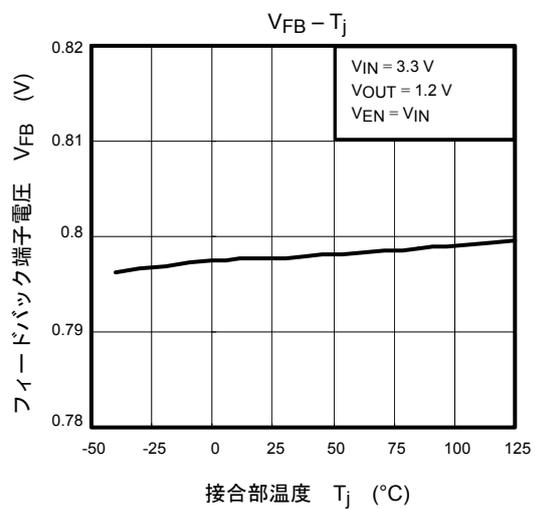
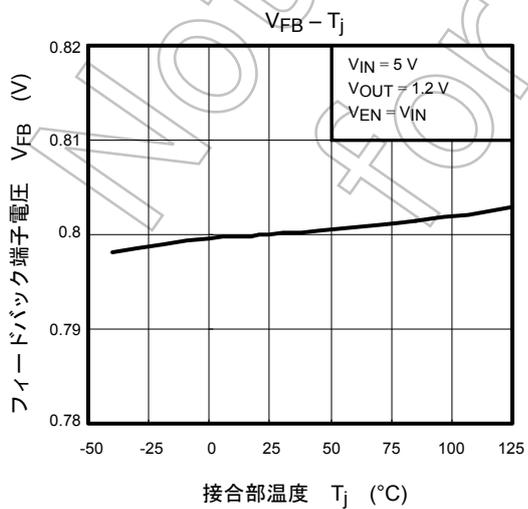
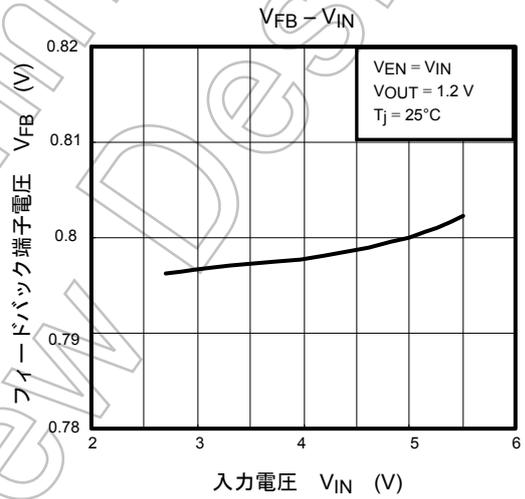
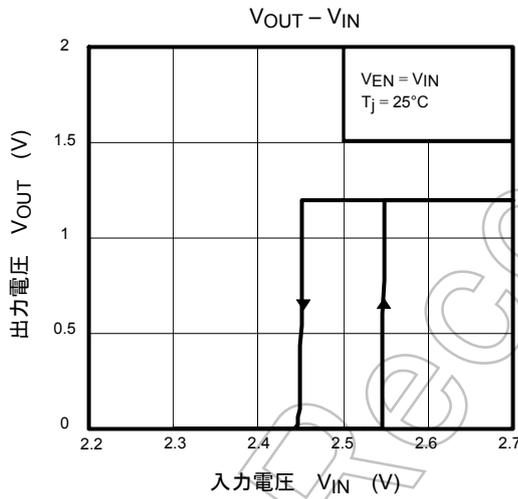
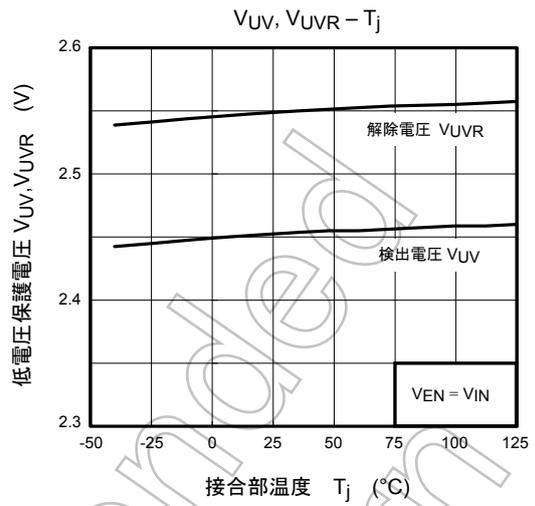
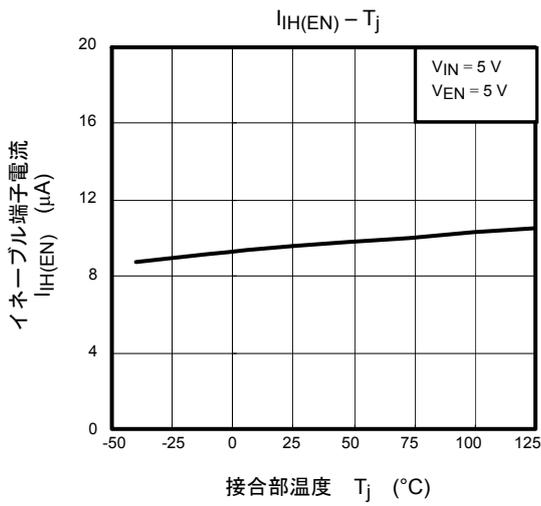
図 6 過熱保護動作

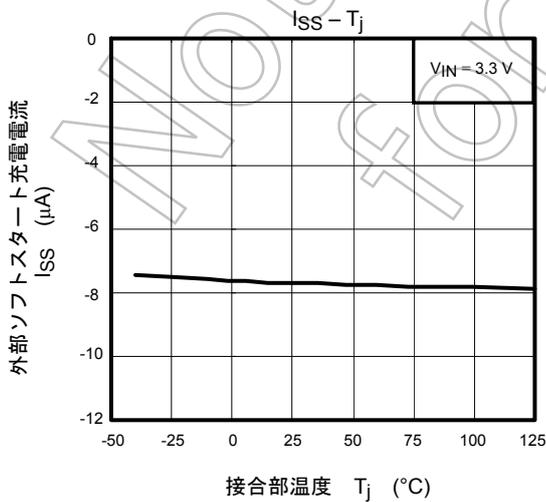
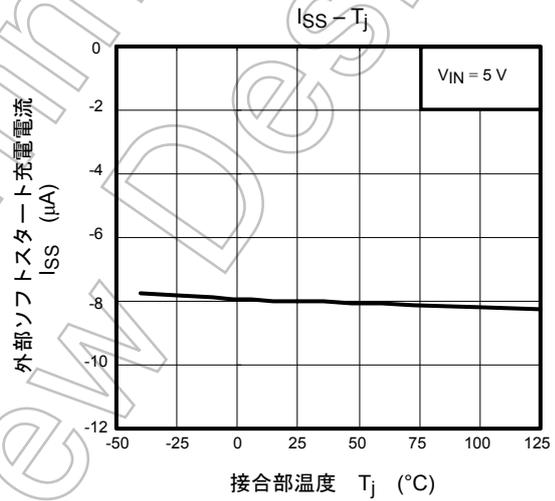
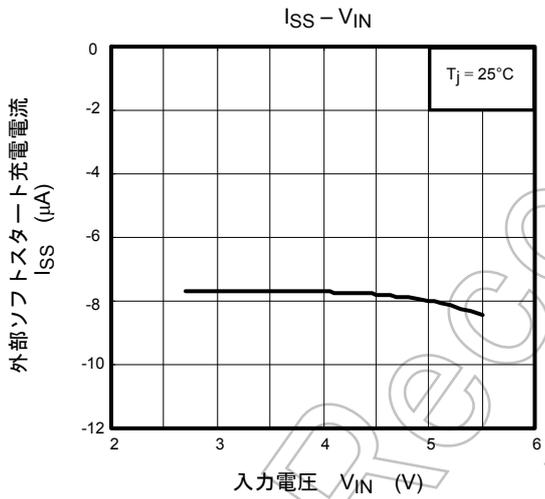
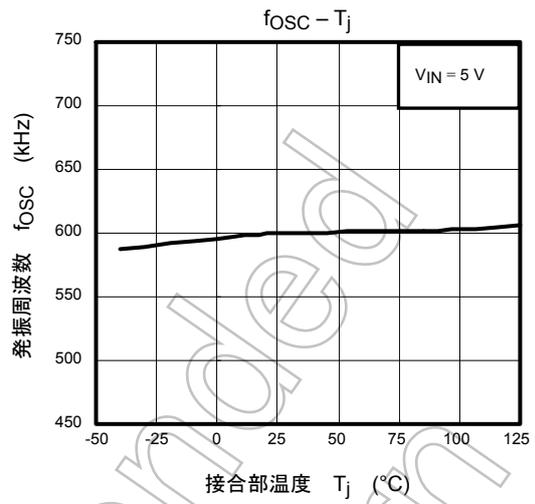
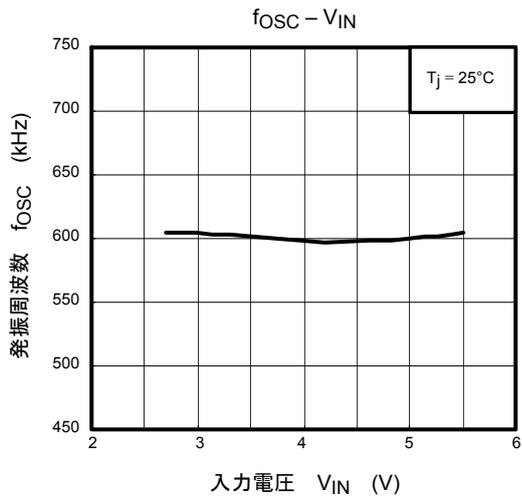
使用上の注意

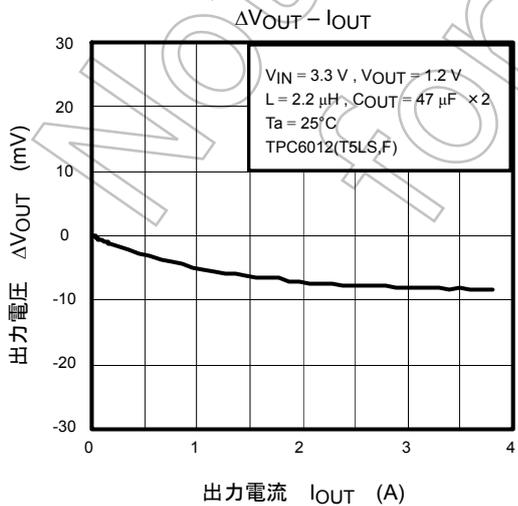
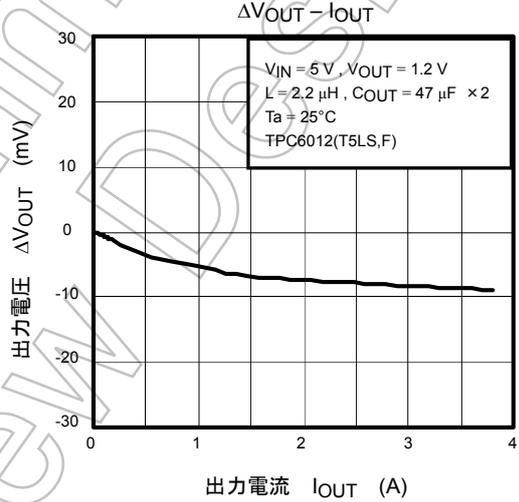
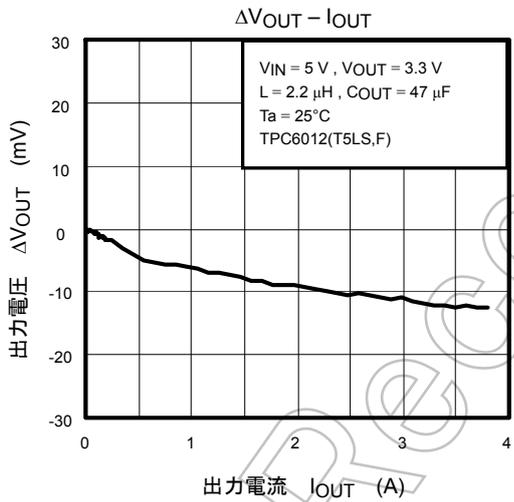
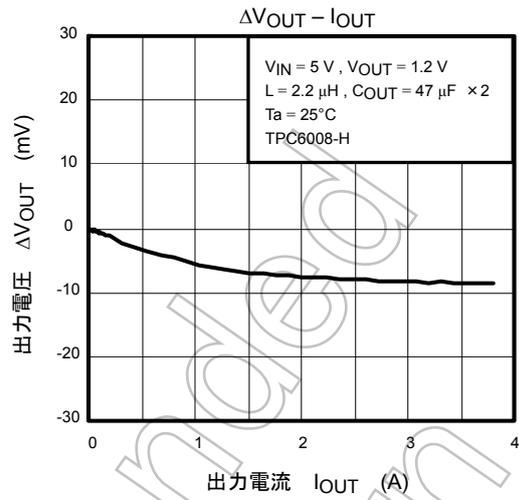
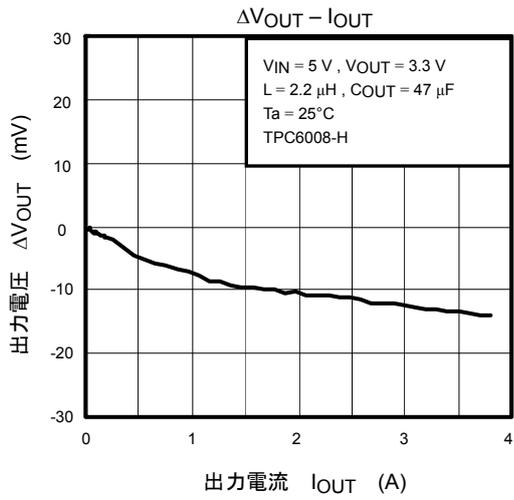
- ご使用になる入力電圧、出力電圧、出力電流、温度、コンデンサ、インダクタ、抵抗の種類や特性を十分考慮の上、最終的にはご使用になるセットで実際に動作確認して部品選定をしてください。
- 本製品の周辺部品として記載されている製品は代表的な使用例を示すもので、供給が不可能となる場合があります。ご使用になる場合は最新の情報を確認してください。
- コンデンサ、インダクタ、抵抗等の周辺部品は本製品の出来る限り近い場所に配置してください。
- イネーブル端子と制御部入力端子間には、静電気保護用ダイオードが内蔵されています。イネーブル端子と制御部入力端子間電圧は $V_{EN} - V_{IN2} < 0.3\text{ V}$ となるようにご使用ください。
- GND 端子と V_{IN2} 端子間の直近に $0.1\mu\text{F} \sim 1\mu\text{F}$ 程度のデカップリングコンデンサ C_C を接続してください。また、 C_C を接続する際、 V_{IN2} 端子と V_{IN1} 端子間に 100Ω 程度の抵抗を挿入すると V_{IN2} 端子のリプル電圧が低減され、動作を安定にすることができます。
- 最小設定可能出力電圧は 0.8V (標準) です。入出力電位差が小さくなると、レギュレーション動作が十分に行われなくなり、出力電圧の変動が大きくなる場合があります。
- 本製品の GND 端子 (4 番ピン) 及びパッケージ裏面の電極は IC チップの裏面に接続され放熱する構造となっています。放熱のために十分な GND パターンの面積を確保するようにしてください。
- 本製品の過電流保護回路は短時間且つわずかな程度に過剰な電流から一時的に本製品を保護するものであり、どのような場合でも本製品を保護するわけではありません。過電流保護動作後は直ちに過電流状態を解除するようお願いいたします。絶対最大定格を超えた場合など、ご使用方法や状況により、過電流保護回路が正常に動作しなかったり、動作する前に本製品が破壊したりすることがあります。
- 過熱保護回路は短時間且つわずかな程度に過剰な熱から一時的に本製品を保護するものであり、どのような場合でも本製品を保護するわけではありません。過熱保護動作後は、速やかに過熱状態を解除するようお願いいたします。絶対最大定格を超えて使用した場合など、ご使用方法や状況により、過熱保護回路が正常に動作しなかったり、動作する前に本製品が破壊したりすることがあります。

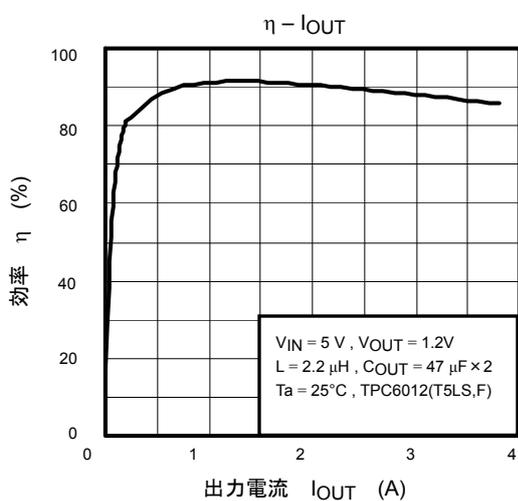
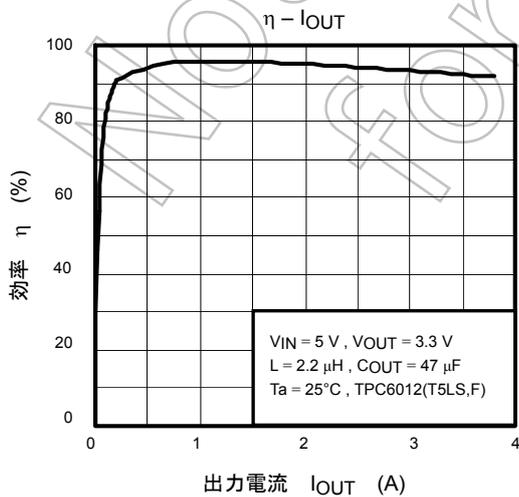
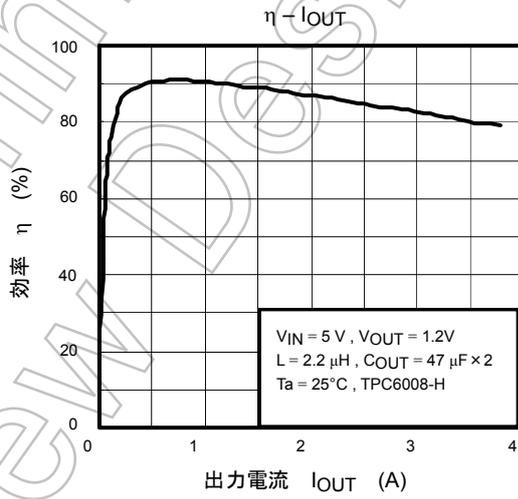
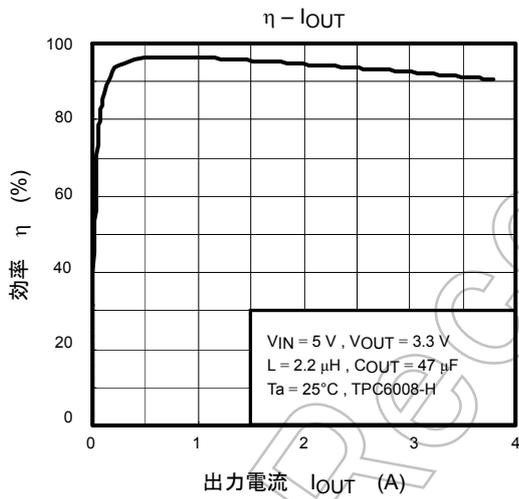
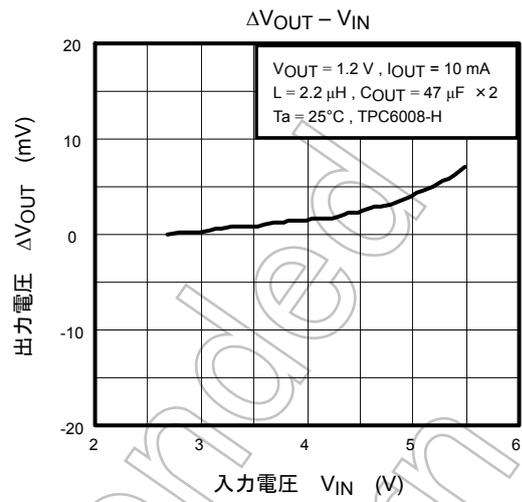
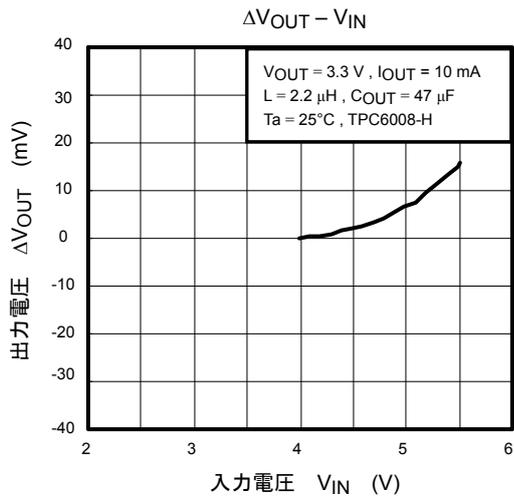
特性グラフ

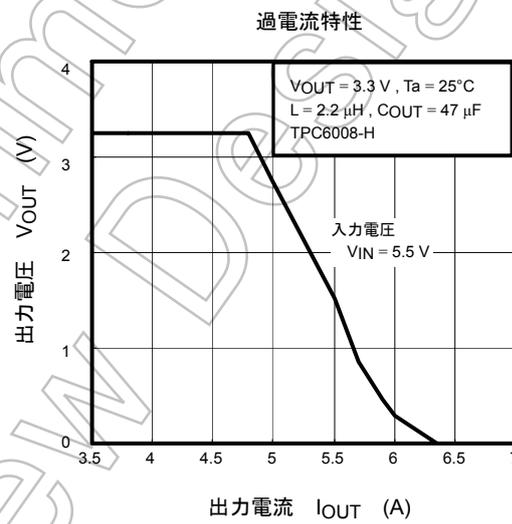
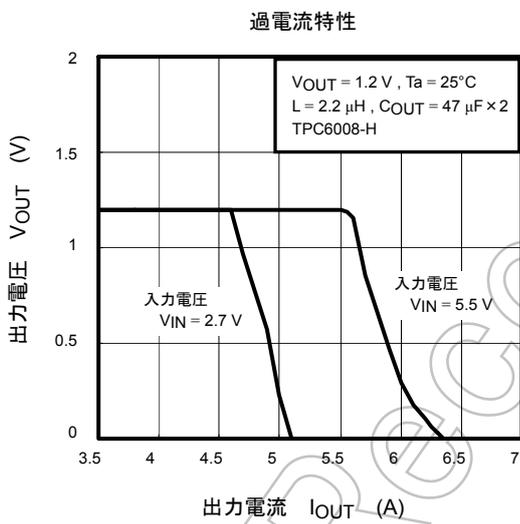
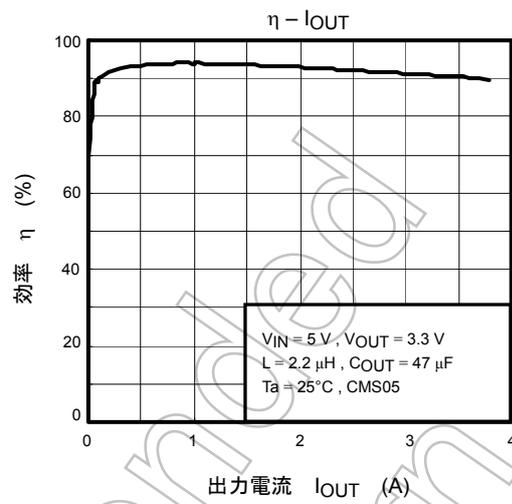
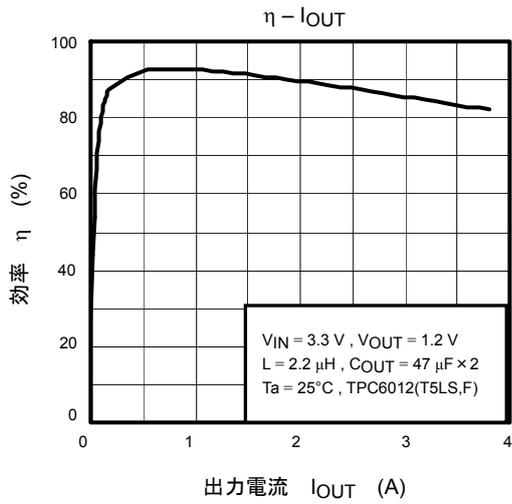




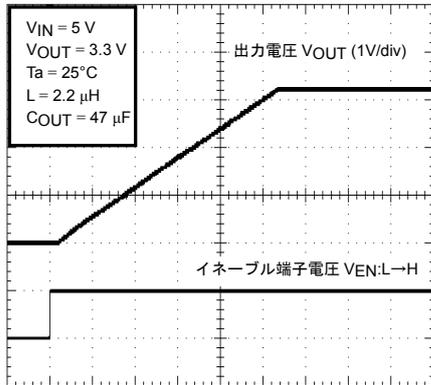






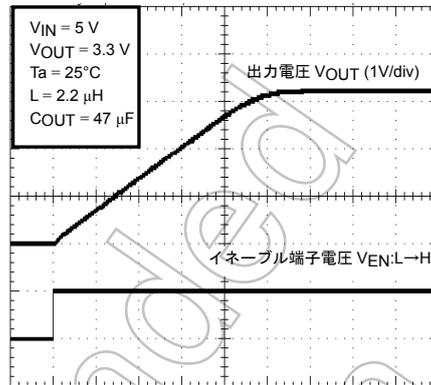


起動特性
(内部ソフトスタート時間)



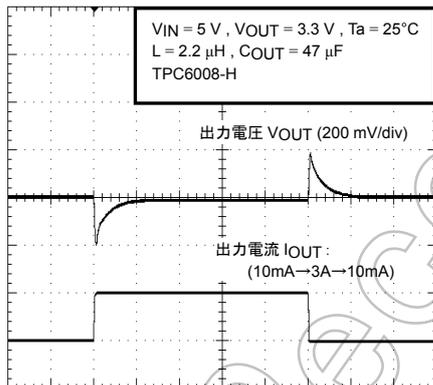
200 μs/div

起動特性
($C_{SS} = 0.1 \mu\text{F}$)



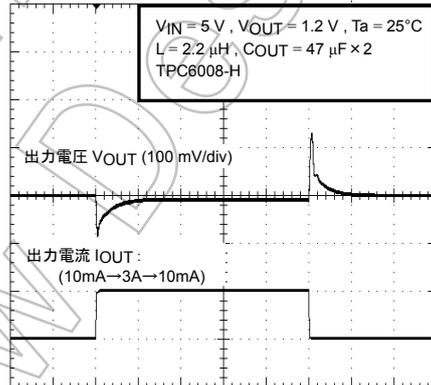
2 ms/div

負荷応答特性



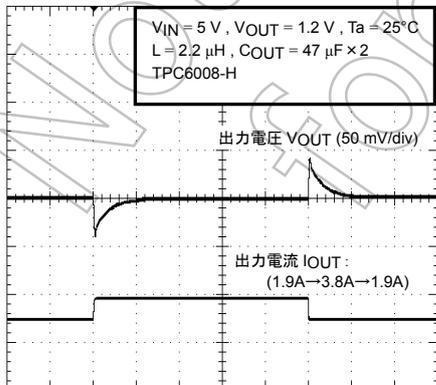
100 μs/div

負荷応答特性



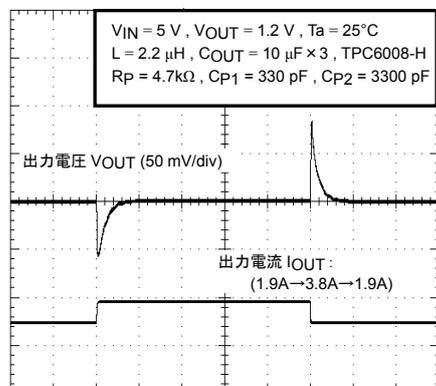
100 μs/div

負荷応答特性



100 μs/div

負荷応答特性
(外部位相補償回路追加)



100 μs/div

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことを願います。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。